



Grundlagenforschung und Anwendungskonzepte im Bereich der Synthese und Charakterisierung hochfrequenztauglicher ferromagnetischer Nanokompositschichten

K. Seemann, H. Leiste, K. Krüger

Institute for Applied Materials IAM-AWP



KIT – University of the State of Baden-Wuerttemberg and National Research Center of the Helmholtz Association

www.kit.edu



Motivation

Grundlagen

- Modelle der ferromagnetischen Resonanz (FMR)
- Hypothese Schicht-Materialdesign für hohe FMR

Prinzip der Schichtherstellung und Schichtkonditionierung

- Phasendiagramme Fe-Co und Hf-N als Grundlage der Dünnschichtsynthese von Fe-Co-Hf-N- Nanokompositschichten

Ergebnisse der Schichtstruktur

- Transmissionselektronenmikroskop- Beugungsuntersuchungen (TEM)
- Nanostruktur und Kristallitgrößen

• Uniaxiale Anisotropie und Präzession magn. Momente in Schichten

- Entstehung der uniaxialen Anisotopie (min. der magnetokristallinen Anisotropie)
- Modell der Spinpräzession und dessen indirekte Messung
- Dämpfung der Präzession

Anwendungsbeispiele

Zusammenfassung





Motivation

Grundlagen

- Modelle der ferromagnetischen Resonanz (FMR)
- Hypothese Schicht-Materialdesign für hohe FMR
- Prinzip der Schichtherstellung und Schichtkonditionierung
- Phasendiagramme Fe-Co und Hf-N als Grundlage der Dünnschichtsynthese von Fe-Co-Hf-N- Nanokompositschichten

Ergebnisse der Schichtstruktur

- TEM- Beugungsuntersuchungen
- Nanostruktur und Kristallitgrößen
- Uniaxiale Anisotropie und Präzession magn. Momente in Schichten
- Entstehung der uniaxialen Anisotopie (Min. der magnetokristallinen Anisotropie)
- Modell der Spinpräzession und dessen indirekte Messung
- Dämpfung der Präzession
- Anwendungsbeispiele
- Zusammenfassung

Allg. Modelle der ferromagnetischen Resonanz



Quasiklassische Beschreibung

 \Rightarrow Landau-Lifschitz-Gilbert DGL

der Resonanzabsorption

Quantenmechanik der Resonanzabsorption

Aufhebung der e⁻ Spinentartung im H- Feld (Spin-1/2-Magnetismus):



Bsp. Energie bei 2,4 GHz: $\Delta E = 1.59 \times 10^{-24} \text{ J} = 9.92 \times 10^{-6} \text{ eV}$

[1] T.L. Gilbert, IEEE Trans. Mag. 40, (2004) 3443 [2] K. Seemann*, H. Leiste, V. Bekker, J. Magn. Magn. Mater. 278, (2004) 200

Institute for Applied Materials IAM-AWP

<u>Hypothese – Schicht-Materialdesign für hohe,</u> (verlustarme) ferromagnetische Resonanz (FMR)

• Ferromagnetische Phase mit hohem magnetischem Moment und Sättigungsmagnetisierung



Ch. Kuhrt, L. Schultz, J. Appl. Phys. 71 (1992) 1896
 G. Herzer, IEEE Trans. Magn. 26 (1990) 1397
 G. Herzer, J. Magn. Magn. Mater. 294 (2005) 99

- Hohe Sättigung durch Wahl des Fe-Co Verhältnisses
- Aber Verluste durch H_c (K1, $\lambda_s)$



- Magnetische Vorzugsrichtung (uniaxiales Anisotropiefeld H_u)
- Weichmagnetisches Verhalten



- Einschränkung des Kornwachstums (Fe-Co) durch refraktäres Element -Nitrid-Phase
- $\Rightarrow \text{Min. von } H_c, \text{d.h., von} \\ H_a(K_1, \lambda_s) [2,3]$
- \Rightarrow Min. magnetokristalline Anisotropieenergie F_a









Motivation

- Grundlagen
- Modelle der ferromagnetischen Resonanz (FMR)
- Hypothese Schicht-Materialdesign für hohe FMR

Prinzip der Schichtherstellung und Schichtkonditionierung

- Phasendiagramme Fe-Co und Hf-N als Grundlage der Dünnschichtsynthese von Fe-Co-Hf-N- Nanokompositschichten
- Ergebnisse der Schichtstruktur
- TEM- Beugungsuntersuchungen
- Nanostruktur und Kristallitgrößen
- Uniaxiale Anisotropie und Präzession magn. Momente in Schichten
- Entstehung der uniaxialen Anisotopie (min. der magnetokristallinen Anisotropie)
- Modell der Spinpräzession und dessen indirekte Messung
- Dämpfung der Präzession
- Anwendungsbeispiele
- Zusammenfassung

Prinzip der Schichtherstellung und Schichtkonditionierung im statischen Magnetfeld





Die Phasendiagramme Fe-Co [1] und Hf-N [2] als Grundlage der Dünnschichtsynthese von Fe-Co-Hf-N- Schichten



[1] I. Ohnuma et al., Acta Materialica 50 (2002) 379

[2] H. Okamoto, Bulletin of Alloy Diagrams 11 (1990) 146





Motivation

Grundlagen

- Modelle der ferromagnetischen Resonanz (FMR)
- Hypothese Schicht-Materialdesign für hohe FMR

Prinzip der Schichtherstellung und Schichtkonditionierung

 Phasendiagramme Fe-Co und Hf-N als Grundlage der Dünnschichtsynthese von Fe-Co-Hf-N- Nanokompositschichten

Ergebnisse der Schichtstruktur

- TEM- Beugungsuntersuchungen
- Nanostruktur und Kristallitgrößen
- Uniaxiale Anisotropie und Präzession magn. Momente in Schichten
- Entstehung der uniaxialen Anisotopie (min. der magnetokristallinen Anisotropie)
- Modell der Spinpräzession und dessen indirekte Messung
- Dämpfung der Präzession
- Anwendungsbeispiele
- Zusammenfassung

TEM- Beugungsuntersuchungen an Fe-Co-Hf-N- Schichten [1]



 $Fe_{36}Co_{40}Hf_9N_{15} = (Fe_{47}Co_{53})_{76}Hf_9N_{15}$



Fe Co

Fe-Co- Mischkristall: αFe-Struktur (bcc) $Fe_{34}Co_{43}Hf_{12}N_{11} = (Fe_{44}Co_{56})_{77}Hf_{12}N_{11}$





[1] K. Seemann*, H. Leiste, Ch. Klever, J. of Magn. Magn. Mater. 321 (2009) 3149

Mikrostruktur [1] und Kristallitgrößen [2] von Fe-Co-Hf-N- Schichten









Motivation

Grundlagen

- Modelle der ferromagnetischen Resonanz (FMR)
- Hypothese Schicht-Materialdesign für hohe FMR
- Prinzip der Schichtherstellung und Schichtkonditionierung
- Phasendiagramme Fe-Co und Hf-N als Grundlage der Dünnschichtsynthese von Fe-Co-Hf-N- Nanokompositschichten
- Ergebnisse der Schichtstruktur
- TEM- Beugungsuntersuchungen
- Nanostruktur und Kristallitgrößen

• Uniaxiale Anisotropie und Präzession magn. Momente in Schichten

- Entstehung der uniaxialen Anisotopie (min. der magnetokristallinen Anisotropie)
- Modell der Spinpräzession und dessen indirekte Messung
- Dämpfung der Präzession
- Anwendungsbeispiele
- Zusammenfassung

Uniaxiale Anisotropie (magn. Vorzugsrichtung) in der Schicht durch Tempern im statischen Magnetfeld



Diffusionanisotropie: Änderung der Bindungsenergie $(\Delta w(\delta r_{Fe-Co}, T, \phi) \neq 0)$ durch kettenförmige Anordnung von Fe und Co bei Temperatur T im Magnetfeld



 \Rightarrow Anisotrope Nahordnung bzw. uniaxiale Anisotropie H_u in der Schichtebene Theoretische Abschätzung der gegenseitigen Beeinflussung der uniaxialen ↔ magnetokristallinen Anisotropie:



<u>Beweis der uniaxialen Anisotropie in der</u> <u>Schichtebene</u>



Messung der Magnetisierung M bzw. Polarisation J = μ_0^*M :



Quasiklassisches Modell der homogenen Spinpräzession in ferromagnetischen Schichten





Entmagnetisierungsfaktoren: N_{yy} = 1 \Rightarrow N_{xx} = N_{zz} = 0

$$\left| \mathbf{H}_{\text{eff}} \right|^2 = \mathbf{H}_{u}^2 + \mathbf{M}_{s} \cdot \mathbf{H}_{u} \quad (\text{für } \mathbf{h}_{x} < \mathbf{H}_{u})$$

Lösung der homogenen und inhomgenen Landau-Lifschitz-Gilbert DGL (LLG) unter Berücksichtigung der uniaxialen Anisotropie, Probenform und Wirbelstromcharakteristik [1]:

$$\frac{\partial \mathbf{M}}{\partial t} = -\gamma \mathbf{M} \times \mathbf{H}_{eff} + \frac{\alpha_{eff}}{M_{eff}} \left(\mathbf{M} \times \frac{\partial \mathbf{M}}{\partial t} \right)$$



[1] K. Seemann*, H. Leiste, K. Krüger, J. Magn. Magn. Mater. 321 (2012) 3149

Messung des Frequenzverhaltens bzw. der Magnetisierungsdynamik (Permeabilitätsspektren)



Messung mit Z_0 = 50 Ω Strip-line-Permeameter bis 5 GHz und Netzwerkanalysator [1,2]:



S-Reflexionsparameter: (Strip-line Charakteristik)

$$S_{11} = S_0 \cdot e^{-\frac{i 4 \cdot \pi \cdot f \cdot (\mu_{eff}) \cdot \varepsilon_{eff}}{c_0}} \rightarrow \mu_r(f) = \mu^{|}(f) + i\mu^{||}(f)$$

[1] V. Bekker*, K. Seemann, H. Leiste, J. Magn. Magn. Mater. 270 (2004) 327[2] Y. Liu et al., Ong, Rev. Sci. Instrum. 76 (2005) 063911



Institute for Applied Materials IAM-AWP

<u>Resonanzlinienverbreiterung HF-Verluste</u> (Dämpfung der Präzession magn. Momente)





Inhomogene Linienverbreiterung:

- Resonanzen anderer magn. Phasen oder einzelner Kristallite
- hohe Fluktuationen in H_u und J durch stärkeren Einfluss der Kristallanisotropie

Imaginärteil "lorentzförmig" \Rightarrow homogene Linienverbreiterung:



 $\alpha_{\rm eff} = \alpha_{\rm int} + \alpha_{\rm ext}$ $\Delta f_{\rm eff} = \Delta f_{\rm int} + \Delta f_{\rm ext}$

Intrinsische Eigenschaften:

- Zeeman- Übergang
- Streuung von itineranten Elektronen am Gitter (Phononen) durch Spin-Bahndrehimpuls Kopplung ξ(R_n) [1,2]

Extrinsische Eigenschaften:

- Entartete Spinwellen mit f_{FMR}
- 2- Magnonenstreuung an nichtmagn. Phasen, Poren, Gitterinhomogenitäten...[3,4] (stat. Mode k ≈ 0 → k > 0)

[1] V. Kamberský, Can. J. Phys. 48 (1970) 2906

- [2] K. Seemann*, H. Leiste, Ch. Klever, J. of Magn. Magn. Mater. 322 (2010) 2979
- [3] M.J. Hurben, D.R. Franklin, C.E. Patton, J. Appl. Phys. 81 (1997) 7458
- [4] K. Seemann*, H. Leiste, J. of Magn. Magn. Mater. 321 (2009) 742



Motivation

Grundlagen

- Modelle der ferromagnetischen Resonanz (FMR)
- Hypothese Schicht-Materialdesign für hohe FMR

Prinzip der Schichtherstellung und Schichtkonditionierung

 Phasendiagramme Fe-Co und Hf-N als Grundlage der Dünnschichtsynthese von Fe-Co-Hf-N- Nanokompositschichten

Ergebnisse der Schichtstruktur

- TEM- Beugungsuntersuchungen
- Nanostruktur und Kristallitgrößen

Uniaxiale Anisotropie und Präzession magn. Momente in Schichten

- Entstehung der uniaxialen Anisotopie (Min. der magnetokristallinen Anisotropie)
- Modell der Spinpräzession und dessen indirekte Messung
- Dämpfung der Präzession

Anwendungsbeispiele

Zusammenfassung

<u>Anwendungsbeispiele</u>

Patent (Mikroinduktor): Nr. 101 04 648 No. US 2003/0160675 A1 A. v. d. Weth, K. Seemann, I. Fergen



20

03.05.2012

Patent (Reflexionsdämpfung): Nr. 10 2005 022 473 No. US 7,834,818 B2 K. Seemann, H. Leiste, V. Bekker, S. Zils



[1] K. Seemann*, H. Leiste, V. Bekker, J. of Magn. Magn. Mater. 302 (2006) 321



DFG Projekt: SPP 1299 HAUT

"Nanostrukturierte magnetische Dünnschicht-Komposite für Anwendungen in der Hochtemperatur-Sensorik"

("Magnetoelastischer Effekt")



Klaus Seemann

Institute for Applied Materials

<u>Zusammenfassung</u>



- Ausarbeitung theoretischer Modelle zur Beschreibung der Wechselwirkung zw. TM- Wellen und ferromagnetischen Nanokompositschichten
- Voraussetzungen und Hypothesen f
 ür das Schichtdesign
- Ergebnisse der statischen und dynamischen Magnetisierung bzw. Schichteigenschaften
- Demonstration von Anwendungspotentialen in der Mikroelektronik, EMV- und Sensortechnik